

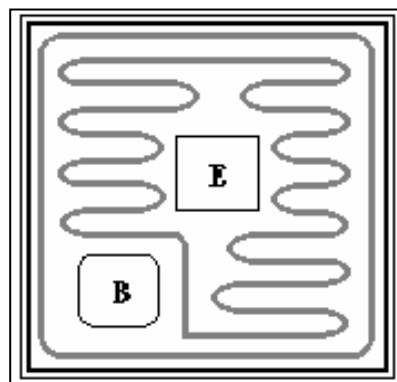


M28S 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：C060AJ-01
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：600×600μm²
 焊位尺寸：B 极 130×150μm²；E 极 140×130μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：M28S，HM28S

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....850mW
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....20V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....6V
 I_C——集电极电流.....1.25A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	20			V	I _C =1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =100μA, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	300				V _{CE} =1V, I _C =1mA
		300		1000		V _{CE} =1V, I _C =100mA
		300				V _{CE} =1V, I _C =300mA
		300				V _{CE} =1V, I _C =500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.55	V	I _C =600mA, I _B =20mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =600mA, I _B =20mA
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	V _{CB} =35V, I _E =0
I _{CES}	集电极—发射极截止电流			100	nA	V _{CE} =20V, V _{BE} =0
I _{EBO}	发射极—基极电流			100	nA	V _{EB} =6V, I _C =0
f _T	特征频率	100			MHz	V _{CE} =5V, I _C =50mA